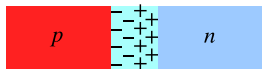
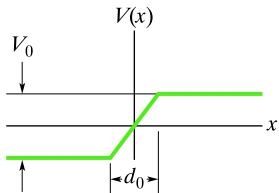




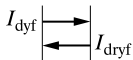
a)



b)



c)



d)

Rys. 42.11. a) Złącze  $p$ - $n$ . b) Przepływ nośników większościowych przez płaszczyznę złącza powoduje wystąpienie ładunku przestrzennego związanego z nieskompensowanymi jonami donorów (po prawej stronie złącza) i akceptorów (po lewej stronie złącza). c) Z powstaniem obszaru ładunku przestrzennego o szerokości  $d_0$  wiąże się kontaktowa różnica potencjałów  $V_0$ . d) Dyfuzja nośników większościowych (zarówno elektronów, jak i dziur) przez płaszczyznę złącza wywołuje przepływ prądu dyfuzji  $I_{dyf}$ . (W rzeczywistym złączu  $p$ - $n$  granice obszaru zubożonego nie są ostre, a zatem zależność potencjału kontaktowego od położenia (rys. c) nie jest krzywą łamaną)